METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE AND DEVELOPMENT APPARATUS

Publication number: JP2004006788 (A)

Publication date: 2004-01-08

Inventor(s): NAGAI MASAHARU; UEHARA ICHIRO Applicant(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

Classification:

- international: G02F1/1368; G03F7/40; H01L21/027; H01L21/3065; H01L21/336; H01L29/41;

H01L29/423; H01L29/49; H01L29/786; G02F1/13; G03F7/40; H01L21/02; H01L29/40; H01L29/66; (IPC1-7): H01L21/027; G02F1/1368; G03F7/40; H01L21/3065; H01L21/336; H01L29/41; H01L29/423; H01L29/49; H01L29/786

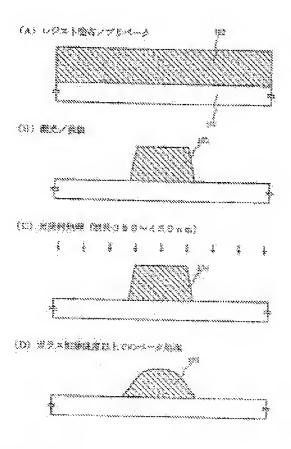
- European:

Application number: JP20030101633 20030404

Priority number(s): JP20030101633 20030404; JP20020102178 20020404

Abstract of JP 2004006788 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a semiconductor device which ensures process margin in respect of a resist removing property, and achieves a balance between the formation of resist patterns each having a desired wall angle and the removing property of the resist pattern.; SOLUTION: The method comprises processes for; forming the resist patterns each consisting of a positive resist comprising photosensitive materials; irradiating light, which is within a photosensitive wavelength of a photosensitizer, to the resist patterns; and baking the resist patterns at a temperature exceeding the glass-transition temperature.; COPYRIGHT: (C) 2004.JPO



Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) **公 開 特 許 公 報(A)** (11) 特許出願公開番号

特開2004-6788 (P2004-6788A)

(43) 公開日 平成16年1月8日 (2004. 1.8)

(51) Int.C1. ⁷	F 1				テーマ	· = -	(参考	(
HO1L 21/027	HO1L	21/30	576		2 H O	92		
GO2F 1/1368	GO2F	1/1368			2 H O	96		
GO3F 7/40	GO3F	7/40	501		4M1	04		
HO1L 21/3065	HO1L	21/30	570		5 F O	04		
HO1L 21/336	HO1L	21/30	572A		5 F O	46		
	審査請求 未	語求 請求	項の数 7	OL	(全 35	頁)	最終了	夏に続く
(21) 出願番号	特願2003-101633 (P2003-101633)	 (71) 出願人	. 000153	878				
(22) 出願日	平成15年4月4日 (2003.4.4)		株式会	社半導体	エネルー	ギー研究	究所	
(31) 優先権主張番号	特願2002-102178 (P2002-102178)		神奈川	県厚木市	長谷39	98番	地	
(32) 優先日	平成14年4月4日 (2002.4.4)	(72) 発明者	永井	雅晴				
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		神奈川	県厚木市	長谷39	98番	地株	式会社
			半導体	エネルギ	一研究所	折内		
		(72) 発明者						
				県厚木市			地株	式会社
				エネルギ				
		F ターム (*	参考) 2H0			JA29	JA34	JA35
				JA38		JB22	JB31	JB61
				KA04		MA08	MA13	MA15
				MA16		MA19	MA22	MA27
				MA30	MA35	MA37	NA25	NA29
				RA05			終頁に	空生 ナ
						月叉	以分	NOTE N

(54) 【発明の名称】半導体装置の作製方法及び現像装置

•••••